



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	SOI MOS晶体管
专利类别:	发明专利
申请号:	201210155387.9
申请日期:	2012-05-18
专利号:	201210155387.9
第一发明人:	李莹;毕津顺;罗家俊;韩郑生
实施情况:	授权
专利证书号:	201210155387.9
其它备注:	硅器件中心

